OXIDE

株式会社オキサイド

2022年2月期第3四半期 決算補足説明資料

(6521 東証マザーズ) 2022年1月13日

2022年2月期 第3四半期決算

- ・業績および進捗
- ・事業別売上構成
- ・今期のこれまでのトピックス
- ・事業別説明【光計測・新領域/半導体/ヘルスケア】
- ・今期計画に対する進捗【人員/研究開発費/設備投資】

本資料は当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

本資料に掲載されている事項は、資料作成時点における当社の想定及び所信に基づく見解であり、その情報の正確性及び完全性を保証または約束するものではありません。 実際の業績に影響を与えるリスクや経済動向、業界需要などの不確実要因を含んでいます。

当社の見込みと実際の業績は異なる場合があります。ご了承ください。

- ・業績および進捗
- ・事業別売上構成
- 今期のこれまでのトピックス
- ・事業別説明【光計測・新領域/半導体/ヘルスケア】
- ・今期計画に対する進捗【人員/研究開発費/設備投資】





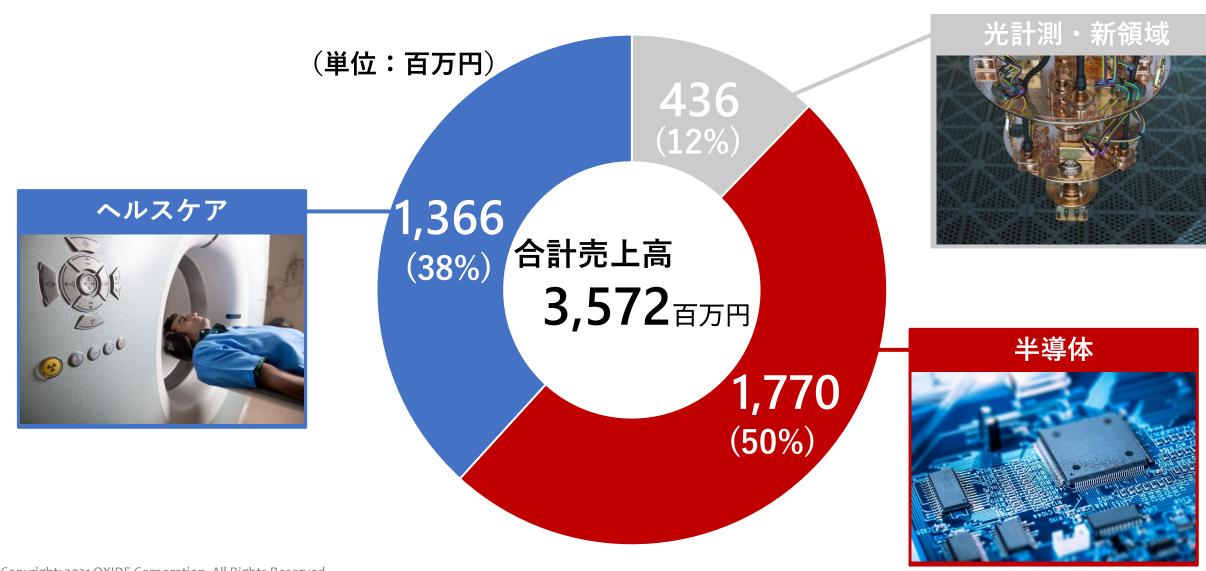
(単位:百万円)

	通期予想				3Q 累計	進捗率
		1Q	2Q	3Q	उप ज्ञला	(通期予想比)
売上高	4,810	1,154	1,298	1,120	3,572	74.3%
売上総利益	1,583	381	434	403	1,219	77.0%
販管費	1,027	258	219	246	724	70.5%
営業利益	554	122	215	157	495	89.4%
営業利益率	11.5%	10.6%	16.6%	14.0%	13.9%	
営業外損益	25	6	1	-4	3	12.0%
経常利益	578	129	216	152	499	86.3%
減価償却費合計	289	61	64	68	194	67.1%

- ・業績および進捗
- ・事業別売上構成
- 今期のこれまでのトピックス
- ・事業別説明【光計測・新領域/半導体/ヘルスケア】
- ・今期計画に対する進捗【人員/研究開発費/設備投資】

事業別売上構成 第3四半期累計





- ・業績および進捗
- ・事業別売上構成
- ・今期のこれまでのトピックス
- ・事業別説明【光計測・新領域/半導体/ヘルスケア】
- ・今期計画に対する進捗【人員/研究開発費/設備投資】

今期のこれまでのトピックス

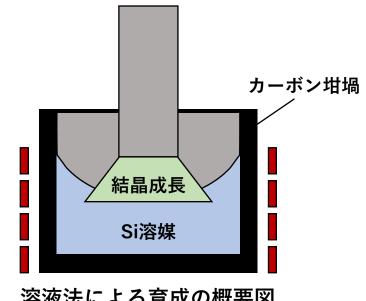


2021年	4月 5日	東京証券取引所マザーズ上場 1
	5月28日	第21回定時株主総会
	6月18日	GaN薄膜成長用 新材料単結晶基板「SAM」サンプル出荷開始に ついてのプレスリリース
	6月24日	新製品 フェムト秒レーザ「OneFive ORIGAMI 03XP-3P」国内 2 し販売開始についてのプレスリリース
	7月2日	サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金(2次 公募)採択についてのプレスリリース
	9月14日	新市場区分「グロース市場」選択に関するプレスリリース
	10月14日	株式会社UJ-Crystalとの資本業務提携に関するプレスリリース

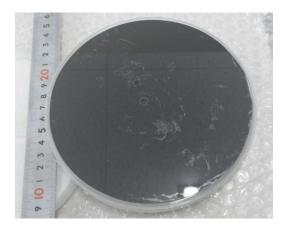
UJ-Crystalとの資本業務提携 -溶液法によるSiC単結晶



- 株式会社UJ-Crystal(以下、UJC社)は、国立大学法人 東海国立大学機構名古屋大学 宇治原徹教授が中心となり 設立された、パワー半導体SiC単結晶の開発、製造、販売 を目指すスタートアップ企業です。
- 名古屋大学およびUJC社は、SiC結晶を溶液法で育成でき る技術を保有しています。
- 溶液法は、Si融液中にCを溶解させ、種結晶からSiC結晶 を成長させる技術です。
- 熱歪みが小さいため、大口径化が容易で、育成中の結晶 内温度勾配が小さく欠陥が少ない特長があります。
- 溶液法は、当社が得意としている単結晶育成技術の内、 CZ法と技術的親和性が高い手法です。



溶液法による育成の概要図



6インチSiC結晶

- ・業績および進捗
- ・事業別売上構成
- 今期のこれまでのトピックス
- ・事業別説明【光計測・新領域/半導体/ヘルスケア】
- ・今期計画に対する進捗【人員/研究開発費/設備投資】

事業別説明【光計測・新領域】

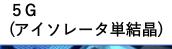


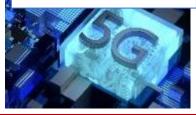
(単位:百万円)

進捗率 3Q累計 通期予想 (通期予想比)

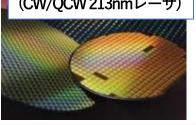
売上高 559 436 78.0%

グローバルニッチ マーケット





半導体検査装置 (CW/QCW 213nmレーザ)



放射能汚染モニタ



医療用ボタン電池 (単結晶個体電池材料)



競争優位性が 期待できる マスマーケット

MicroLED (フェムト秒レーザ)



フォトマスク (描画用レーザ)



レーザ照明 (蛍光体単結晶・デバイス)



パワー半導体 (GaN基板用単結晶)



6月24日適時開示

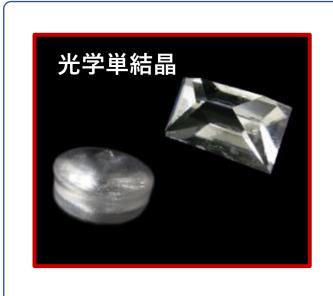
6月18日適時開示

事業別説明【半導体】



(単位:百万円)

半導体ウェハ欠陥 当社の製品群







イメージ写真: 半導体ウエハ欠陥検査装置

事業別説明【ヘルスケア】

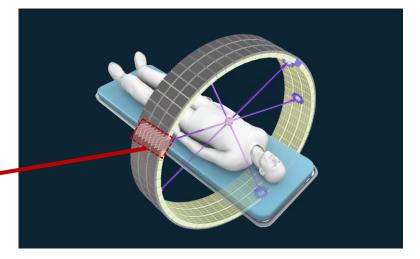


(単位:百万円)

	通期予想	3Q累計	進捗率 (通期予想比)
売上高	1,652	1,366	82.7%

PET検査装置 に用いる 当社の製品



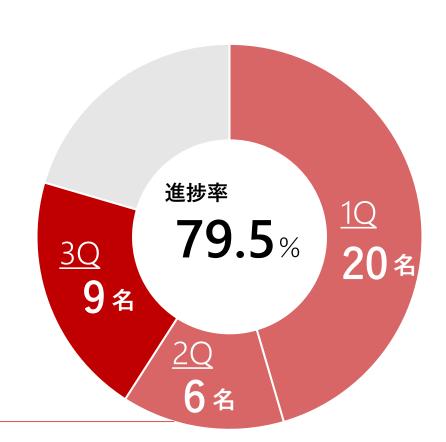


PET検査装置のしくみ

- ・業績および進捗
- ・事業別売上構成
- 今期のこれまでのトピックス
- ・事業別説明【光計測・新領域/半導体/ヘルスケア】
- ・今期計画に対する進捗【人員/研究開発費/設備投資】

今期計画に対する進捗【人員】

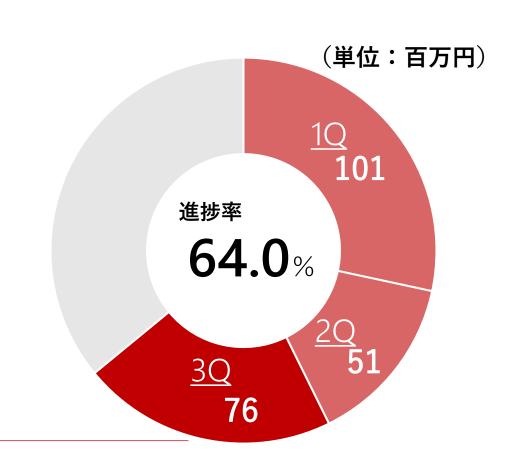




通期計画:44名



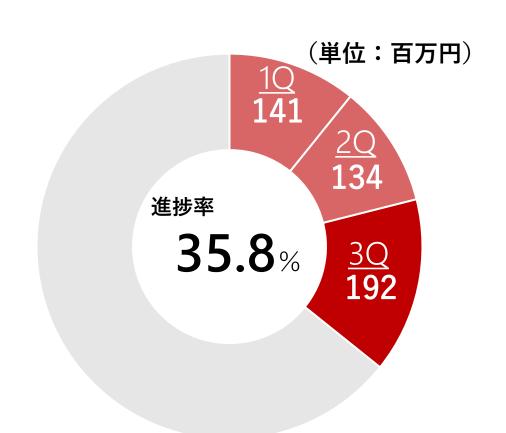




通期計画: 356

今期計画に対する進捗【設備投資】





通期計画: 1,306

OXIDE

https://www.opt-oxide.com

Appendix





(単位:百万円)

	2021年2月期 3Q	2022年2月期 3Q	前年同期比
売上高	1,038	1,120	107.9%
売上総利益	386	403	104.4%
販管費	154	246	159.9%
営業利益	232	157	67.6%
営業利益率	22.3%	14.0%	_
営業外損益	-15	-4	_
経常利益	217	152	70.1%
減価償却費合計	56	68	121.8%

OXIDE

事業別説明【光計測・新領域】 2Qからの進捗



6月18日適時開示

パワー半導体 | GaN基板用単結晶

- ▶ 開発したGaN基板用単結晶"SAM"について、プレスリリース以降、複数の企業・大学より問い合わせがありました。
- ▶ 一部顧客においてはGaN試作のプログラムが始まりました。
- > 応用物理学会にて、SAM基板上のGaInNの結晶成長と評価について、名城大学とオキサイドの共著での発表を行いました。



6月24日適時開示

MicroLED | フェムト沙レーザ

デンマークのNKT Photonics と共同で開発し2021年6月30日より国内において販売開始した紫外(UV)フェムト秒レーザ「OneFive ORIGAMI03XP-3P」は、顧客による評価が進んでいます。



事業別説明【光計測・新領域】- SAM※サンプル出荷 -

※:SAM: ScAIMgO4単結晶基板

- SAMは、半導体材料であるGaN薄膜単結晶(以下GaN)の成長に適した単結晶基板です。
- ➤ SAMをGaN成長の基板として使うことで、完全性の高い膜を 構成することが原理的に可能となり、高性能なGaNデバイス の実現が期待できます。
- ➤ GaNは、青色発光ダイオードとして普及していますが、最近では可視光レーザやパワーデバイス用の半導体材料としても研究開発がすすみ、一部で実用化が始まっております。
- 国内外の複数の機関へサンプル出荷をしています。



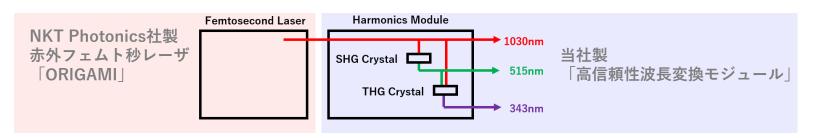






事業別説明【光計測・新領域】- UVフェムト秒レーザ出荷 -

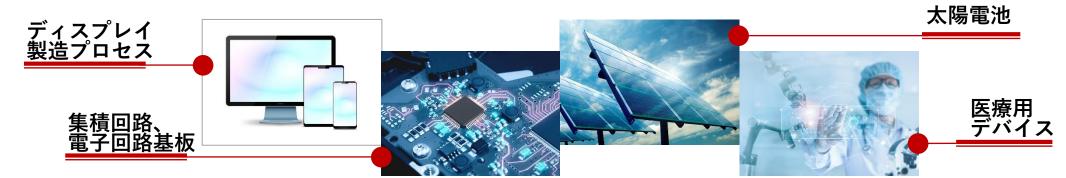
- NKT Photonics社との業務提携による共同開発製品化第一弾となります。
- 波長を同一レーザヘッドから出力することができます。
- PC制御での波長選択が可能です。





ORIGAMI03XP-3P

様々な分野での微細加工用レーザとしての応用が期待されています。





事業別説明【光計測・新領域】- SiC単結晶 -

- ➤ SiC単結晶は、従来のSiに比べ、送電時の電力ロスや交流・直流変換時の電力ロスを大幅に削減可能なパワー半導体材料で、カーボンニュートラルに向けた省電力化に極めて重要な材料である。
- SiCパワー半導体の市場は、2019年で約540億円、2025年で約2,500億円である※1。
 - ※1:出所:Yole Developmentのデータを元に経産省が加工(デバイス部門)

Si・SiCの物性比較

物性	Si	SiC
バンドギャップ ev	1.1	3.3
電子移動度 cm²/Vs	1350	700
破壊電界 MV/cm	0.3	3.0
Baliga's 性能指数※2 εμ _e Ε _c ³	1	440

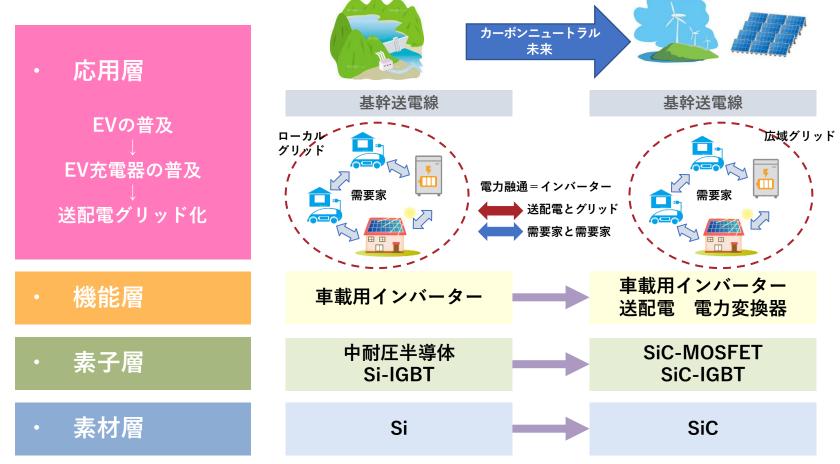
※2:Baliga's 性能指数:パワーFET通電効率

- ▶ UJ-Crystalは、国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学宇治原徹教授が中心となり設立された、パワー半導体SiC単結晶の開発、製造、販売を目指すスタートアップ企業で、溶液法を用いてSiC単結晶を育成する。
- 溶液法は、当社が得意としている単結晶育成技術の内、高周波誘導加熱CZ法と技術的親和性が高い。

事業別説明【光計測・新領域】- SiC単結晶 -



- SiC単結晶の使用例として、電気自動車への搭載が挙げられます。
- > EVの普及は、電力制御用SiCデバイスの需要を加速し、カーボンニュートラルを実現します。



EV普及が加速するカーボンニュートラルの産業アーキテクチャ





> SiC結晶成長法:従来法(昇華法)と溶液法の違い

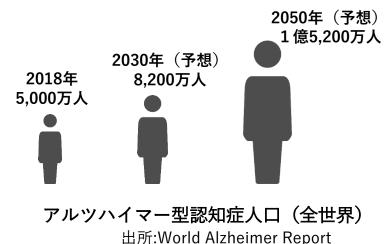
SiC 結晶成長法	昇華法 従来の成長方法。 現在、販売されているSiCは すべてこの方法で生産され ている。	溶液法 (TSSG法) 名古屋大学が保有するシーズ。 世界で6インチのSiC結晶をこの手法で実現できているのは、 名古屋大・UJC社のみ。	
結晶成長の原理	原料を高温で昇華させ、種結晶上で再結晶させる。 結晶中に温度勾配を形成する:熱歪みがある (結晶成長表面からの抜熱)	SiとCを溶解させて種結晶から成長させる。 結晶中に温度勾配を形成しない:熱歪みが極めて小さい (結晶成長表面への溶質の物質移動)	
大口径化	大口径化で熱歪みが増加。	熱歪みが小さいため大口径化が容易。	
低欠陥密度	欠陥の原因が熱歪みにある。	温度勾配が小さく欠陥が少ない。	
長尺化	閉鎖された反応槽での成長であり制限があり。 また、長尺化で熱歪みが増加。	シリコンのように引き上げ成長でもあるため長尺化が容易。 熱歪みの影響も小さい。	
成長スピード	成長スピードの向上には大きな温度勾配が必要。 欠陥密度とトレードオフ。	成長スピードは炭素の供給律速であり、温度勾配を必要としない。	

事業別説明【ヘルスケア】 今後の展望(頭部PETの動向)



- アルツハイマー型認知症の患者数は、年々増加しており、2050年には1億5,200万人に到達すると予想されています。
- 頭部PET検査は、アルツハイマー型認知症の原因物質アミロイド β の検査方法の一つです。
- 米国において、アルツハイマー型認知症の新たな治療薬が承認されました。 一方、欧州及び日本においては、現状未承認となっております。





2018(国際アルツハイマー病協会)



